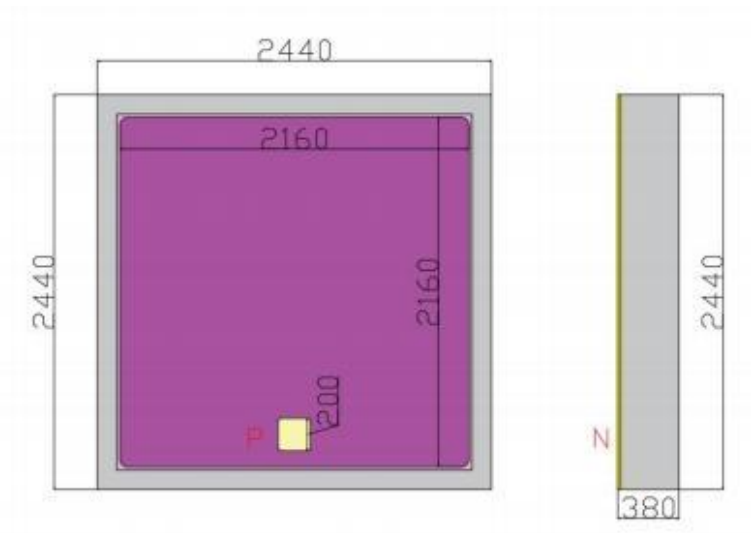


Кремниевый фотодетекторный чип 2.44 мм — техническое описание

P/N : WS9B-01C

Применение
Si PIN фотодиодный чип

Структура
Планарная структура: PIN-диод;
электроды: задняя сторона (катод) — Au, верхняя сторона (анод) — Al



ГАБАРИТЫ

Габариты	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Активная область	2160 x 2160 ± 15			мкм
Ширина чипа	2440			мкм
Длина чипа	2440			мкм
Высота чипа	360	380	400	мкм
Размер контактной площадки	190	200	210	мкм

Электрооптические характеристики (при Ta=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Прямое напряжение	Vf	If=10mA, H=0	0.7		1.3	В
Обратное напряжение	Vbr	Ir=100μA, H=0	35			В
Рабочий диапазон длин волн	λ		400	940	1100	нм
Обратный темновой ток	Id	Vr=10V			10	нА
Емкость	Cj	VR=3V, f=1MHz		16		пФ